

AF4Y115HA85J 1.48 μ m円筒モジュール

エルビウムドープファイバアンプ励起用光源として開発された、温度制御素子（TEC）非搭載のアンクルドタイプ1.48 μ m帯高出力LDモジュールです。

特長

- ・ SMF光出力 : 150mW ($I_f < 800\text{mA}$)
- ・ 動作環境温度 : -5 \sim +70 $^{\circ}\text{C}$ (ケース温度)
- ・ 同軸モジュール
- ・ 低消費電力 : <1W



用途

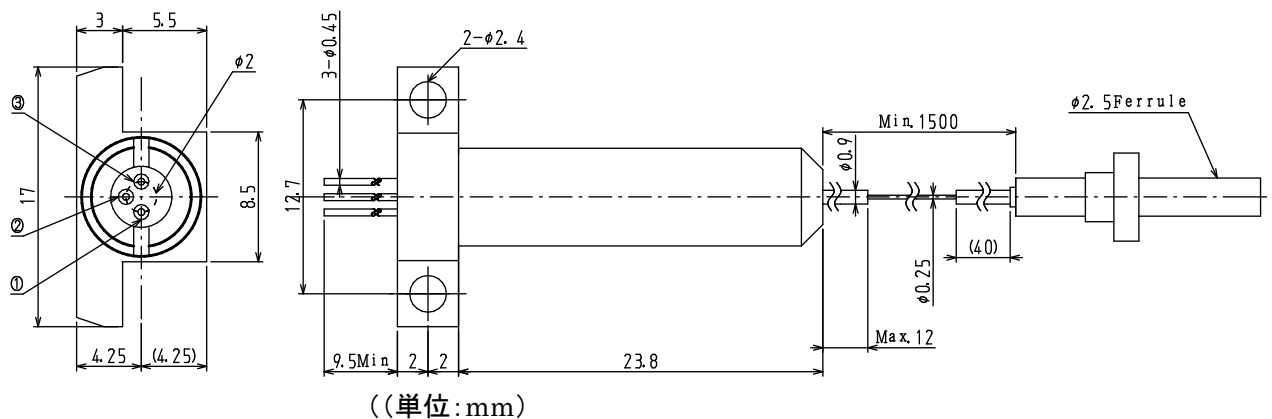
- ・ EDFA励起用光源

絶対最大定格

項目	記号	定格	単位
LD順電流	I_f	1000	mA
LD逆電圧	V_R	2	V
動作ケース温度	T_C	-5 \sim +70	$^{\circ}\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-40 \sim +85	$^{\circ}\text{C}$

* 絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。

外形寸法



端子接続

No.	FUNCTION
1	LDカソード
2	NC
3	LDアノード

電氣的・光学的特性 (T_C=70°C)

項目	記号	測定条件	Min.	Typ.	Max.	単位
しきい値電流	I _{th}	T _C =25°C		60		mA
		T _C =70°C		130		
中心波長	λ _C	P _F =150mW, RMS (-20dB)	1450		1490	nm
順電流	I _F	P _F =150mW			800	mA
順電圧	V _F	P _F =150mW			2	V



CAUTION : Handle the fiber of the enclosed device(s) with extreme care ; glass fiber is subject to breakage if mishandled and permanent damage to the device may result. Do not pull the device by the fiber or protective sleeve.

Do not coil the fiber into a loop of than 30 mm in radius.

SEMICONDUCTOR LASER

INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO
DIRECT OR SCATTERED RADIATION

AVOID EXPOSURE
Invisible laser radiation is emitted from this aperture

OUTPUT POWER 500mW
WAVELENGTH 0.80 to 1.80 μm
CLASS IIIb LASER PRODUCT

Caution - use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
This Product Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
Manufactured Anritsu Corp. 5-1-1 Onna, Atsugi-shi, Kanagawa, Japan

アンリツ株式会社

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

アンリツ株式会社 デバイスビジネス部 国内営業部

アンリツデバイス株式会社 マーケティング部

〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-5

TEL 046-296-1228 FAX 046-296-1254

URL: <https://www.anritsu.com/anritsu-devices>

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。